

## st意法STD140N6F7

产品名称	st意法STD140N6F7
公司名称	深圳市合通泰电子有限公司
价格	.15/个
规格参数	品牌:st意法 型号:STD140N6F7 批次:21+
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503
联系电话	0755-82965240 18145855552

## 产品详情

该N-沟道功率MOSFET利用STripFET?F7技术和增强型沟槽栅极结构，可降低通态电阻，同时降低内部电容和栅极电荷，从而使开关速度更快、能效更高。

制造商编号：STD140N6F7

制造商：STMicroelectronics

说明：MOSFET LGS LV MOSFET

制造商: 意法半导体

产品种类: MOSFET

RoHS：详细信息

技术: Si

安装风格: 贴片/贴片

封装 / 箱体: TO-252-3

晶体管极性: N通道

通道数量: 1个频道

Vds-漏源极击穿电压: 60伏

Id-连续漏极电流: 80 安

Rds On-漏源导通电阻: 3.1 毫欧

Vgs - 栅极-源极电压: - 20 伏 , + 20 伏

Vgs th-栅源极阈值电压: 2伏

Qg-栅极电荷: 55 纳克

最小工作温度: - 55 摄氏度

最大工作温度: + 175 摄氏度

Pd-功率耗散: 134 瓦。

通道模式: 增强

商标名: StripFET

封装: 卷轴

封装: 剪胶带

封装: 鼠标卷轴

商标: 意法半导体

配置: 单身的

下降时间: 20 纳秒

产品类型: MOSFET

上升时间: 68 纳秒

系列: STD140N6F7

2500

子类别: MOSFET

晶体管类型: 1 N 通道

典型关闭延迟时间: 39 纳秒

典型接通延迟时间: 24 纳秒

单位重量: 330 毫克